## (19)日本国特許庁 (JP)

į.

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-349314

(43)公開日 平成6年(1994)12月22日

H01B 1/16	<b>A</b>						
	Α	7244-5G					
C 0 3 C 8/22							
H01G 4/12	361						
H 0 5 K 1/09	Z	6921-4E					
			審查請求	未請求 請求項の数1 FD (全 5 頁)			
1)出願番号	特願平5-160447	<u> </u>	(71)出願人	000006231			
				株式会社村田製作所			
2)出顧日	平成5年(1993)6月	3日		京都府長岡京市天神二丁目26番10号			
			(72)発明者	大谷 明			
				京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式			
				会社村田製作所内			
			(72)発明者	<b>狩野</b> 東彦			
				京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式			
				会社村田製作所内			
			(72)発明者	虫本 修二			
				京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式			
				会社村田製作所内			
			(74)代理人	弁理士 西澤 均			

## (54) 【発明の名称】 導電性ペースト

## (57) 【要約】

【目的】 メッキ液に対する耐性が大きく、特性の劣化を防止することが可能で、信頼性の高い外部電極を形成することが可能な導電性ペーストを提供する。

【構成】 導電粉末と、ガラスフリットと、有機ビヒクルとを含有してなるセラミック電子部品の外部電極形成用の導電性ペーストにおいて、ガラスフリットとして、 ZnO, SiO2, B2O3, 及びアルカリ土類金属とアルカリ金属の酸化物の少なくともいずれか一方を含有してなるガラスフリットであって、(a) 軟化点が540~570℃の低軟化点ガラスフリット20~80重量%と、(b) 軟化点が575~620℃の高軟化点ガラスフリット80~20重量%とを混合してなる混合ガラスフリット80~20重量%とを混合してなる混合ガラスフリットを用いる。

I

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電粉末と、ガラスフリットと、有機ビ ヒクルとを含有してなるセラミック電子部品の外部電極 形成用の導電性ペーストであって、

前記ガラスフリットは、ZnO, SiO2, B2O3, 及 びアルカリ土類金属とアルカリ金属の酸化物の少なくと もいずれか一方を含有するホウケイ酸亜鉛系ガラスフリ ットからなり、前記ホウケイ酸亜鉛系ガラスフリット は、

(a) 軟化点が540~570℃の低軟化点ガラスフリ ット20~80重量%と、

(b) 軟化点が575~620℃の高軟化点ガラスフリ ット80~20重量%とを混合してなる混合ガラスフリ ットからなることを特徴とする導電性ペースト。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【産業上の利用分野】この発明は、導電性ペーストに関 し、詳しくは、積層セラミックコンデンサなどのセラミ ック電子部品の外部電極を形成するために用いられる導 電性ペーストに関する。

#### [0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】積層セ ラミックコンデンサなどのセラミック電子部品 (素体) に外部電極(端子電極)を形成する場合、従来は、例え ば、Ag, Ag-Pdなどの導電粉末100重量部と、 セラミック電子部品 (素体) との接着力を得るために配 合されるガラスフリット(例えばホウケイ酸亜鉛系ガラ スフリット) 1~30重量部を含有してなる導電性ペー ストを用い、これをセラミック電子部品(素体)に塗布 した後、焼成することにより、外部電極を形成してい る。

【0003】そして、このようにして外部電極が形成さ れる積層セラミックコンデンサなどのセラミック電子部 品には、外部電極の半田濡れ性などの特性を向上させる ために、NiメッキとSnメッキ、あるいはNiメッキ と半田メッキなどの種々のメッキ処理を施すようにした もの(メッキ品)がある。

【0004】しかし、従来のホウケイ酸亜鉛系ガラスフ リットを用いた導電性ペーストにおいては、通常、軟化 点が低い(例えば500~550℃)ホウケイ酸亜鉛系 40 【0011】また、この発明の導電性ペーストにおいて ガラスフリットが用いられることが多く、セラミック電 子部品(メッキ品)の外部電極を形成した場合、メッキ 工程において構成成分の一部であるガラスフリットがメ ッキ液に溶解し、外部電極とセラミック電子部品 (素 体)との間の接着強度が低下するという問題点がある。 【0005】また、ガラスフリットの軟化点が低いた

め、外部電極(導電性ペースト)焼成時に外部電極が収 縮して、セラミック電子部品(素体)を締め付ける力が 強くなり、セラミック電子部品のたわみ強度が低下する という問題点がある。

【0006】さらに、極端な場合には、ガラスフリット が溶出した部分からメッキ液がセラミックの内部に侵入 し、セラミック電子部品(例えば積層セラミックコンデ ンサ)のQ特性を劣化させるというような問題点があ

【0007】この発明は、上記問題点を解決するもので あり、メッキ液に対する耐性が大きく、特性の劣化を防 止することが可能で、信頼性の高い外部電極を形成する ことが可能な導電性ペーストに関する。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、この発明の導電性ペーストは、導電粉末と、ガラス フリットと、有機ビヒクルとを含有してなるセラミック 電子部品の外部電極形成用の導電性ペーストであって、 前記ガラスフリットは、ZnO, SiO2, B2O3, 及 びアルカリ土類金属とアルカリ金属の酸化物の少なくと もいずれか一方を含有するホウケイ酸亜鉛系ガラスフリ ットからなり、前記ホウケイ酸亜鉛系ガラスフリット は、(a)軟化点が540~570℃の低軟化点ガラス フリット20~80重量%と、(b) 軟化点が575~ 620℃の高軟化点ガラスフリット80~20重量%と を混合してなる混合ガラスフリットからなることを特徴 とする。

【0009】なお、この発明の導電性ペーストにおい て、低軟化点ガラスフリットと高軟化点ガラスフリット との割合を上記割合に限定したのは、高軟化点ガラスフ リットの割合が20重量%未満の場合には、外部電極の 引張り強度及び外部電極が形成されたセラミック電子部 品のたわみ強度が不十分になり、また、高軟化点ガラス 30 フリットの割合が80重量%を越えると、耐熱衝撃性が 低下するからである。

【0010】また、この発明の導電性ペーストにおい て、混合ガラスフリットは、導電粉末と混合ガラスフリ ットの合計量(固形分)に対して3~10重量%の範囲 で添加することが望ましい。これは、ガラスフリットの 添加量が導電粉末とガラスフリットの合計量の3重量% 未満になると電極とセラミックとの接着強度が低下し、 また、10重量%を越えるとメッキ付着性が低下するた めである。

は、セラミック電子部品(案体)との熱膨張係数を調整 するために、5重量%程度までの割合で混合ガラスフリ ットにアルミナ (A 12O3) を添加してもよい。

### [0012]

【実施例】以下、この発明の実施例を比較例とともに示 して、その特徴とするところをさらに詳しく説明する。 【0013】この実施例においては、表1に示すような 組成の低軟化点ガラスフリット(フリット番号 I ~ II l) と高軟化点ガラスフリット(フリット番号IV, V) 50 を、表2に示すような割合で混合することにより調製し

-2-

Įì.

た混合ガラスフリットを用いた。

\*【表1】

[0014]

フリット	軟化点の高	軟化点	構 成 成 分 (重量%)							
番号	低の分類	(°C)	ZnO	S i O <sub>2</sub>	B 2 O 3	Na2O	LieO	CaO	A 1 2O 3	
I	低軟化点	565	40	10	40	7		3		
II	低軟化点	545	30	15	45		10			
III	低軟化点	550	35	15	40	5	5	-	_	
IÀ	高軟化点	590	25	35	22	_	5	13	_	
V	高軟化点	595	10	40	25	_	10	10	5	

[0015]

【表2】

	5					6	,,,,,	
	低軟化点フリット		高軟化点	<b>ミフリット</b>	特 性			
試料番号	フリット	配合割合	フリット	配合割合	引張り強度	たわみ強度	熱衝擊試験	
	番号	(重量%)	番号	(重量%)	(N)	(mm)	(%)	
* 1	I	100	_		45	4. 2	0	
2	I	75	IA	25	63	6. 5	0	
3	I	50	IA	50	65	6.8	0	
4	I	25	IA	<b>7</b> 5	67	7. 2	0	
<b>*</b> 5			IV	100	68	7. 4	3	
. 6	11	75	ΙV	25	62	6. 2	0	
7	ΙΙ	25	· IA	75	67	7. 0	0	
8	11	25	V	75	66	6. 9	0	
9	III	50	V	50	85	6. 8	0	
10	111	75	V	25	63	6. 4	0	
11	III	25	V	75	69	7. 1	0	

V

100

69

【0016】また、この実施例においては、導電粉末と してAg粉末を用い、有機ビヒクルとしてセルロース系 樹脂をブチルカルビトールに溶解したものを用いた。

\*12

【0017】そして、Ag粉末(導電粉末)と、上記混 合ガラスフリットと、有機ピヒクルとを配合して混練す ることにより導電性ペーストを調製した。

【0018】なお、この実施例においては、導電性ペー 40 熱衝撃を与えた後の不良品の発生率を示す。 スト中のAg粉末と混合ガラスフリットの合計量(固形 分)を80重量%とし、Ag粉末とガラスフリットの合 計量に対するガラスフリットの割合を6重量%とした。

【0019】上記の導電性ペーストを用いて、積層セラ ミックコンデンサの外部電極(端子電極)を形成した 後、800℃,10分間ピークの条件で焼成した。それ から、外部電極上にNiの電解メッキとSnの電解メッ キを重ねて施した。

【0020】そして、得られた積層セラミックコンデン サについて、そのたわみ強度及び外部電極の引張り強度 50 る。

を測定するとともに、熱衝撃試験を行い、その特性を評 価した。その結果を表2に示す。

7.2

4

【0021】なお、表2において、試料番号に#印を付 したものはこの発明の範囲外のもの(比較例)であり、 その他はこの発明の範囲内の実施例である。

【0022】熱衝撃試験は、温度差 (ΔT) 300℃の

【0023】また、引張り強度及びたわみ強度は、その 値が大きいほど特性が良いことを示す。

【0024】表2より、この発明の実施例の導電性ペー ストを用いて外部電極を形成した積層セラミックコンデ ンサを、試料番号1の比較例の積層セラミックコンデン サ(高軟化点ガラスフリットを含まないガラスフリット を用いた導電性ペーストを使用して外部電極を形成した 積層セラミックコンデンサ)と比較すると、引張り強度 及びたわみ強度のいずれもが向上していることがわか

-4-

7

【0025】また、この発明の実施例の導電性ペーストを用いて外部電極を形成した積層セラミックコンデンサを、試料番号5及び12の比較例の積層セラミックコンデンサ(高軟化点ガラスフリットのみを含むガラスフリットを用いた導電性ペーストを使用して外部電極を形成した積層セラミックコンデンサ)と比較すると、引張り強度及びたわみ強度に顕著な差は認められないが、比較例(試料番号5及び12)については、熱衝撃試験において不良品が発生しており、実施例の導電性ペーストを用いて外部電極を形成したセラミック電子部品の耐熱衝撃性が向上していることがわかる。

【0026】なお、上記実施例では、混合ガラスフリットとして、表1に示すような低軟化点ガラスフリット及び高軟化点ガラスフリットを、表2に示すような所定の割合で混合したガラスフリットを用いた場合について説明したが、混合ガラスフリットを構成する低軟化点ガラスフリット及び高軟化点ガラスフリットの組成、及び低軟化点ガラスフリット及び高軟化点ガラスフリットの混合は、上記実施例に限定されるものではなく、この発明の要旨の範囲内において、任意に変化させることが 20 可能である。

【0027】また、上記実施例では、アルカリ土類金属の酸化物としてCaOを用い、アルカリ金属の酸化物としてLi2Oを用いた場合について説明したが、この発明の導電性ペーストにおいては、これらに限らず、他のアルカリ土類金属の酸化物及びアルカリ金属の酸化物を用いることが可能である。

【0028】また、上記実施例では、導電粉末としてA g粉末を用いた場合について説明したが、この発明の導電性ペーストにおいては、導電粉末はAg粉末に限られ 30 るものではなく、例えばCu粉末などの他の金属粉末、あるいはAg-Pd粉末のような合金粉末などを導電粉末として用いることが可能である。

【0029】さらに、上記実施例では、この発明の導電性ペーストを用いて積層セラミックコンデンサの外部電

極を形成した場合について説明したが、この発明の導電性ペーストは、積層セラミックコンデンサの外部電極のみではなく、セラミック半導体デバイスや正特性サーミスタ装置などの種々のセラミック電子部品の外部電極を形成する場合に使用することが可能である。

8

【0030】この発明は、さらにその他の点においても上記実施例に限定されるものではなく、有機ピヒクルの種類、あるいは各構成成分(導電粉末、混合ガラスフリット及び有機ピヒクル)の配合割合などに関して、発明の要旨の範囲内において、種々の応用、変形を加えることが可能である。

#### [0031]

【発明の効果】上述のように、この発明の導電性ペーストは、ガラスフリットとして、ZnO,SiO₂,B₂O₃,及びアルカリ土類金属とアルカリ金属の酸化物の少なくともいずれか一方を含有してなるホウケイ酸亜鉛系ガラスフリットを用い、そして、このフリットには、

(a) 軟化点が540~570℃の低軟化点ガラスフリット20~80重量%と、(b) 軟化点が575~620℃の高軟化点ガラスフリット80~20重量%とを混合した混合ガラスフリットを用いるようにしているので、メッキ工程における外部電極のメッキ液への溶解を防止し、外部電極及び外部電極を形成したセラミック電子部品の特性の劣化を防止することが可能になる。

【0032】また、軟化点が高いガラスフリットを混合することにより、外部電極(導電性ペースト)焼成時の電極の収縮によるセラミック電子部品(素体)の締め付けが緩和され、たわみ強度を向上させることが可能になる。

【0033】さらに、軟化点の低いガラスフリットを含むため、セラミック電子部品(素体)と外部電極の界面に、熱衝撃に対する緩衝機能を果す反応相が残存し、従来のセラミック電子部品に劣らない高温での耐熱衝撃性を確保することができる。